

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第2区分

【発行日】平成17年9月22日(2005.9.22)

【公開番号】特開2004-4226(P2004-4226A)

【公開日】平成16年1月8日(2004.1.8)

【年通号数】公開・登録公報2004-001

【出願番号】特願2002-158821(P2002-158821)

【国際特許分類第7版】

G 0 3 F 7/039

C 0 8 F 16/14

C 0 8 F 20/10

C 0 8 F 212/14

C 0 8 F 214/00

C 0 8 F 220/42

C 0 8 F 232/08

H 0 1 L 21/027

【F I】

G 0 3 F 7/039 6 0 1

C 0 8 F 16/14

C 0 8 F 20/10

C 0 8 F 212/14

C 0 8 F 214/00

C 0 8 F 220/42

C 0 8 F 232/08

H 0 1 L 21/30 5 0 2 R

【手続補正書】

【提出日】平成17年4月14日(2005.4.14)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

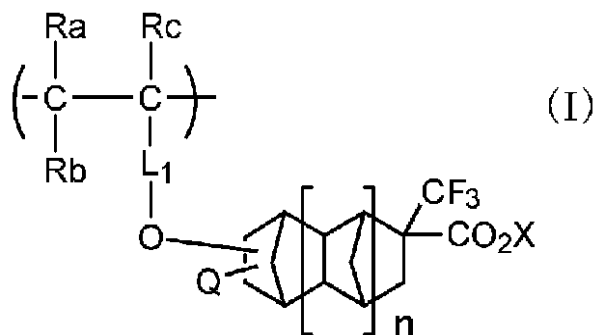
【特許請求の範囲】

【請求項1】

(A) 下記一般式(I)で表される繰り返し単位を有する、酸の作用によりアルカリ現像液への溶解性が増大する樹脂、及び、

(B) 活性光線又は放射線の照射により酸を発生する化合物を含有することを特徴とするポジ型レジスト組成物。

## 【化 1】



一般式 (I) 中、

Ra、Rb 及び Rc は、各々独立に、水素原子、フッ素原子又はフルオロアルキル基を表す。

L<sub>1</sub> は、単結合又は 2 価の連結基を表す。

X は、水素原子又は酸の作用により分解する基を表す。

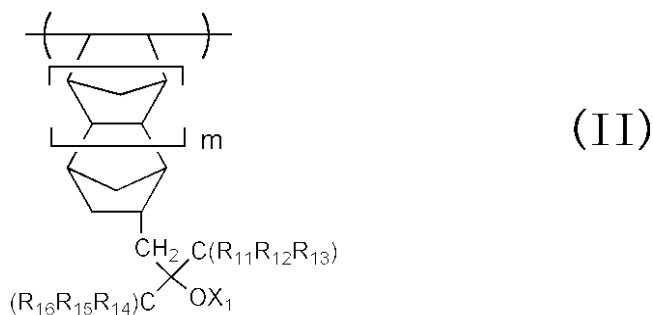
n は、0 又は 1 を表す。

Q は、水素原子又は水酸基を表す。

## 【請求項 2】

(A) 成分の樹脂が、更に下記一般式 (II) ~ (IV) で表される繰り返し単位の群から選ばれる繰り返し単位の少なくとも 1 種を含有することを特徴とする請求項 1 に記載のポジ型レジスト組成物。

## 【化 2】



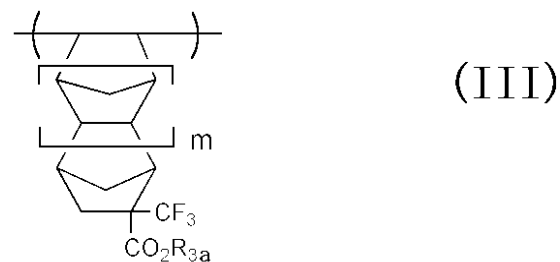
一般式 (II) 中、

R<sub>11</sub> ~ R<sub>16</sub> は、各々独立に、水素原子、フッ素原子又はフルオロアルキル基を表す。但し、R<sub>11</sub> ~ R<sub>16</sub> の少なくとも一つは水素原子ではない。

X<sub>1</sub> は、水素原子又は酸の作用により分解する基を表す。

m は、0 又は 1 を表す。

## 【化 3】

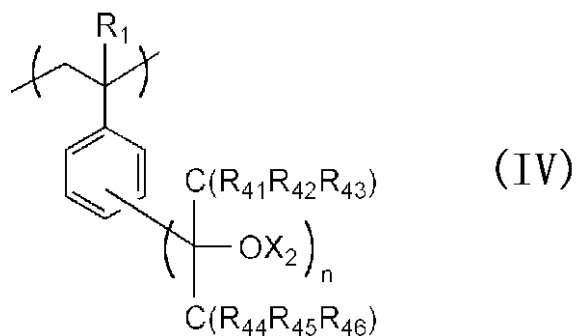


一般式 (III) 中、

R<sub>3a</sub> は、水素原子又は酸の作用により分解する基を表す。

m は、0 又は 1 を表す。

## 【化 4】



一般式 (IV) 中、

$R_1$  は、水素原子、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、シアノ基又はトリフルオロメチル基を表す。

$R_{41} \sim R_{46}$  は、各々独立に、水素原子、フッ素原子又はフルオロアルキル基を表す。但し、 $R_{41} \sim R_{46}$  はの少なくとも一つは水素原子ではない。

$X_2$  は、水素原子又は酸の作用により分解する基を表す。

$n$  は、1～5の整数を示す。 $n$  が2以上である場合に、2つ以上ある  $R_{41} \sim R_{46}$  及び  $X_2$  は、同じでも異なってもよい。

## 【請求項 3】

一般式 (I) 中の  $R_c$  が、フッ素原子又はトリフルオロメチル基であることを特徴とする請求項 1 又は 2 に記載のポジ型レジスト組成物。

## 【請求項 4】

請求項 1～3 のいずれかに記載のレジスト組成物によりレジスト膜を形成し、当該レジスト膜を露光、現像することを特徴とするパターン形成方法。